



## 1. 芯片特征

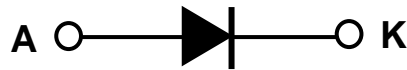
- (1) SIPOS和GPP双层钝化保护工艺
- (2) 单台面外沟槽工艺
- (3)  $V_{RRM} \geq 1600V$
- (4) 正面金属层:AL或Ti-Ni-Ag
- (5) 背面金属层:Ti-Ni-Ag

## 2. 芯片尺寸

- (1) 8.9mm×8.9mm

## 3. 主要用途

- (1) 整流电源
- (2) 其他整流应用



## 4. 产品极限参数

参数名称	符号	单位	测试条件	数值
反向重复峰值电压	$V_{RRM}$	V	$T_j=25^\circ C, I_{RRM}=5\mu A$	1600
反向不重复峰值电压	$V_{RSM}$	V	$T_j=25^\circ C, I_{RSM}=5\mu A$	1700
正向平均电流	$I_{F(AV)}$	A	$T_s=80^\circ C, T_j=150^\circ C$	90
正向浪涌电流	$I_{FSM}$	A	$tp=10ms, \sin 180^\circ, T_j=150^\circ C$	1080
电流时间积分	$I^2t$	$A^2s$	$T_j = 150^\circ C, tp=10ms, \sin 180^\circ$	5800
结温范围	$T_j$	$^\circ C$		-40 ~ 150

## 5. 其他检查标准

参数名称	符号	单位	测试条件	标准数值			检验数量	
				最小值	平均值	最大值		
反向漏电流	$I_R$	mA	$V_R=1600V$	$T_j=25^\circ C$	-	-	0.1	抽检(5%)
				$T_j=145^\circ C$	-	-	3	
正向压降	$V_F$	V	$I_F=5A, \text{芯片测试}, T_j=25^\circ C$	-	0.9	1	全数	
外观检验	(1) 玻璃裂纹			-	-	-		
	(2) 金属层侵蚀			-	-	-		

## 6. 芯片结构

名称	符号	单位	尺寸	说明
芯片尺寸	U	mm	$8.9 \pm 0.05$	
沟槽尺寸	W	mm	$8.0 \pm 0.1$	
金属尺寸	X	mm	$7.9 \pm 0.1$	
芯片厚度	Y	$\mu m$	$300 \pm 10$	
沟槽深度	Z	$\mu m$	$140 \pm 20$	
AL金属层厚度		$\mu m$	$7 \pm 1$	
Ti-Ni-Ag金属层厚度		$\mu m$	1.5~2.0	

